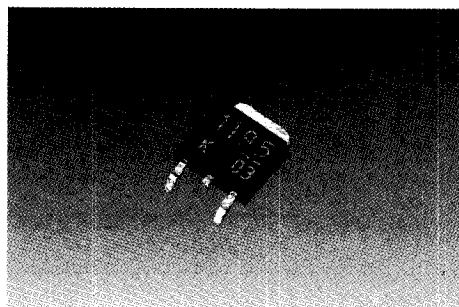


SMD製品シリーズ パワー-MOSFET SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY DEVICE

高速スイッチング
N-チャネル、エンハンスメント型

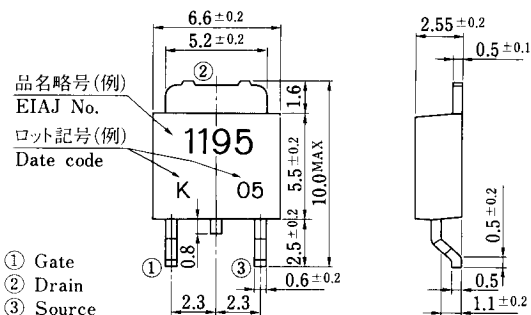
2SK1195
(F1E23)

230V 1.5A



■ 外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Case : E-pack



[Unit : mm]

■ 定格表 RATINGS

■ 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項 目 Item	記 号 Symbol	条 件 Conditions	規 格 値 Ratings	単 位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		-55~150	℃
チャネル温度 Channel Temperature	T _{ch}		150	℃
ドレイン・ソース電圧 Drain・Source Voltage	V _{DSS}		230	V
ゲート・ソース電圧 Gate・Source Voltage	V _{GSS}		±20	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I _D	1.5	A
	Peak	I _{DP}	3	
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		1.5	A
全損失 Total Power Dissipation	P _T	T _C =25℃	10	W

■ 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_C=25℃)

項 目 Item	記 号 Symbol	条 件 Conditions	規格値 Ratings			単 位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain・Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	I _D =250μA, V _{GS} =0V	230			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} =230V, V _{GS} =0V			250	μA
ゲート漏れ電流 Gate・Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} =±20V, V _{DS} =0V			±100	nA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D =1.5A, V _{DS} =10V	0.7	1.4		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain・Source On-state Resistance	R _{DS(ON)}	I _D =1.5A, V _{GS} =10V		1.2	2	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D =0.2mA, V _{DS} =10V	2		4	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source・Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S =1.5A, V _{GS} =0V			1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{JC}	接合部・ケース間 Between junction and case			12.5	℃/W
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz		160		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			20		pF
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}			90		pF
ターンオン時間 Turn-on Time	t _{on}	I _D =1.5A, V _{GS} =10V, R _L =67Ω		37	75	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t _{off}			50	100	ns

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

